

а 2016 0074

Изобретение относится к полупроводниковой технологии и может быть использовано в устройствах для преобразования солнечного излучения.

Способ роста структуры n^+p-p^+ InP для солнечных батарей включает рост эпитаксиального слоя pInP на подложках p^+ InP с кристаллографической ориентацией (100), дезориентацией $3...5^\circ$ в сторону (110) и с концентрацией носителей заряда $1...3 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, рост эпитаксиального слоя n^+ InP и нанесение омических контактов. Слой n^+ InP выращен после газового травления реактора и эпитаксиального слоя pInP.

П. формулы: 1